

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _b =25°C)					電気的特性 (T _b =25°C)										外形	備考
				V _{ceo} (V)	V _{ceo} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{ceo} 最大値 (μA)	直流又はパルスI _{BE}		バイアス		h _{FE}	h _{FE} h _{FE} * (Ω)	h _{FE} h _{FE} * (×10 ⁻⁴)	h _{FE} h _{FE} * (μS)	f _{αb} f _r * (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
 - 9 f_{αb} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_r.
 - 10 C_{ob} AND r_{bb'} OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN r_{bb'} COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
 - 11 OUTLINE
 - 12 REMARKS
- :とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{βT} * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)
									I _{CE5} 500	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CE(V)}	I _{E(mA)}	h _{fb} *									
2SD957	日立	SW	Si. T	1500	6	6 A	50W (T _e =25°C)	150	I _{CE5} 500	1500												102	水平偏向用
" 958	松下	AF	Si. EP	120	7	20	400	135	0.1	50	180~1040	5	2									151	
" 959	"	SW	"	130	7	4 A	30W (T _e =25°C)	150	10	100	60~260	2	500	10	-500							268	
" 960	"	"	"	130	7	4 A	35W (T _e =25°C)	150	10	100	60~260	2	1 A	10	-500							268	
" 961	"	"	"	130	7	5 A	40W (T _e =25°C)	150	10	100	60~260	2	2 A	10	-500							268	
" 962	サンケン	PA	Si. TP	200	6	5 A	80W (T _e =25°C)	150	100	200	3000	4	1 A									102	ターリントン
" 963	"	"	"	200	6	5 A	100W (T _e =25°C)	150	100	200	3000	4	1 A									102	ターリントン
" 964																							
" 965	松下	AF	Si. EP	40	7	5 A	750	150	0.1	10	200~500	2	500	6	-50							138	
" 966	"	"	"	40	7	5 A	1 W	150	0.1	10	200~500	2	500	6	-50							165	
" 967	"	"	"	30	5	200	400	135	0.1	25	7000	10	200									151	ターリントン
" 968	"	"	"	100	5	500	1 W (7リント基板使用)	150			65~330	10	150	10	-50							336	2SB789 とコンプリ
" 969	"	"	"	25	7	500	600	135	0.1	25	65~220	2	500									151	
" 970	日立	SW	Si. T	120	7	8 A	50W (T _e =25°C)	150	160	120	1000~ 20000	3	4 A									268	2SB791 とコンプリ
" 971																							
" 972																							
" 973	松下	AF	Si. EP	30	5	1 A	1 W	150	0.1	20	60~340	10	500									151	
" 974	日立	SW	Si. E	120	5	1 A	900	150	1	100	>150	5	1 A									251	水平偏向用
" 975	"	"	"	150	5	2 A	1 W	150	1	100	>150	5	1.5 A									160	水平偏向用
" 976	"	"	Si. T	300	6	7 A	50W (T _e =25°C)	150	5 mA	300	>25	5	5 A									268	水平偏向用
" 977																							
" 978																							
" 979																							
" 980																							
" 981	富士電機	PA	Si. TP	200	6	5 A	100W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	-500							102	ターリントン
" 982	"	"	"	200	6	5 A	40W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	-500							268	ターリントン
" 983	"	"	"	150	6	6 A	40W (T _e =25°C)	150	1 mA	150	3000	4	1 A	12	-500							268	ターリントン
" 984																							
" 985	日電	PA. SW	Si. E	150	8	1.5 A	10W (T _e =25°C)	150	10	60	2000~ 30000	2	1 A									225	ターリントン
" 986	"	"	"	150	8	1.5 A	10W (T _e =25°C)	150	10	80	2000~ 30000	2	1 A									225	ターリントン